

ATROX[®] 800HT2VX

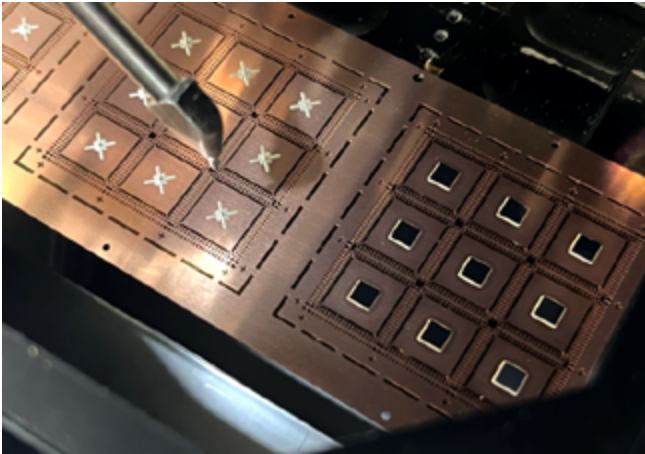
零PFAS混合型银烧结芯片粘接膏

ATROX 800HT2VX 是一种可画胶的热固性芯片粘接银胶，具有极高的导热率，适用于使用金属化芯片的高功率半导体封装。

其低树脂渗出和低挥发性有机物特性，确保出色的封装可靠性。

主要特性优点

- 高导电性和导热性能
- 高产率且可画胶的芯片粘接银胶
- 在不同的基板和框架表面都有非常强的结合力
- 经过验证的MSL等级与可靠性
- 使用亚微米银粉 (平均 <1微米)
- 高粘度/高触变指数可实现紧凑的溢胶范围和缩短芯片到贴片盘边缘的距离
- 防止银胶蔓延和污染薄芯片(≤4mil)顶部
- 亚微米颗粒可实现零孔洞的薄胶厚设定

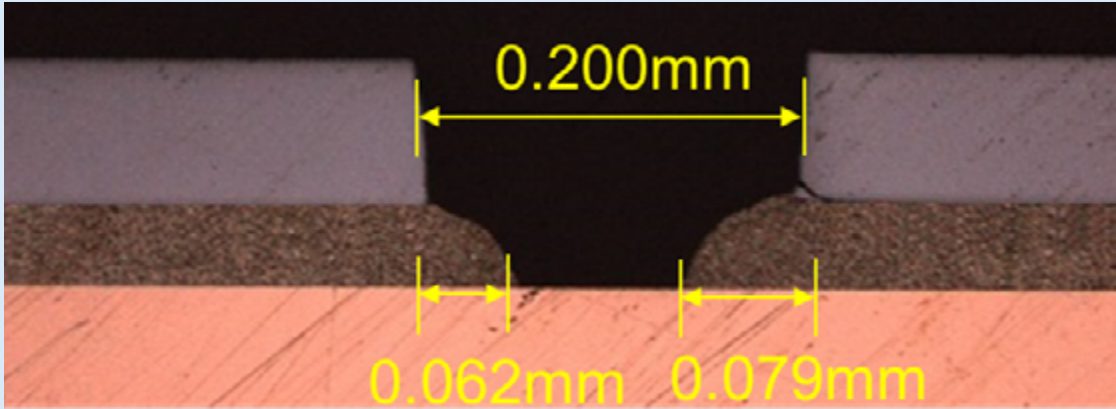


产品特性	
特性	800HT2VX
化学反应类型	热固性
外观	银色
黏度 25°C, 5RPM (cps)	58,000 CPs
触变指数	5.0
有效期 23°C (粘度增加小于 25%)	> 24 小时
银颗粒规格 (平均)	< 1 微米
弹性模量 25°C 260°C	11.7 GPa 2.7 GPa
导热性 (W-mK)	> 175 W/mK
电阻 (ohm.cm)	0.000014
保质期 -40(°C/ °F)	6个月
烘烤曲线	30min +150°C/30min + 20min + 200°C/2hr

ATROX® 800HT2VX

零PFAS混合型银烧结芯片粘接膏

产品性能/测试结果



ATROX® 800HT2VX 尤其适用于薄芯片应用, 因为高粘度/高触变性可防止银胶蔓延到芯片顶部, 从而避免晶片顶部污染。

它具有受控的溢胶范围, 因此两个芯片可以在小于 200um 的紧密间距内, 不相互桥连。

	1_Cu LF 24um	2_Ag LF 24um	3_PPF LF 24um	4_Cu LF 13um	5_Ag LF 13um	6_PPF LF 13um
T0hr						
TC1000						
	0/18 units possible delam	0/18 units possible delam	0/18 units possible delam	0/18 units possible delam	0/18 units possible delam	0/17 units possible delam



ATROX® 800HT2VX 中的亚微米银颗粒可实现在不同导线框架表面的低胶厚设定, 并能达到相当于1mil 胶厚同样优越的作业性和超过1000次热冲击的可靠性。

